


	<p>SI8435DB-T1-E1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8435DB-T1-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 10A 2X2 4-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8435DB-T1-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 150 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




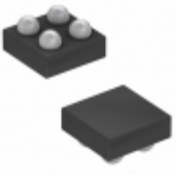


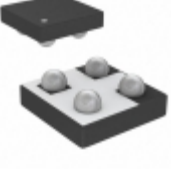

Spezifikationen

Teilenummer	SI8435DB-T1-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 10A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	150 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.78W (Ta), 6.25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Andere Namen	SI8435DB-T1-E1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 10A (Tc) 2.78W (Ta), 6.25W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

SI8435DB-T1-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8435DB-T1-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8435DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8435DB-T1-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8440-A-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8435BB-D-IS1 Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8435BB-D-IS1R Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8439DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>
 <p>SI8435BB-D-ISR Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8435BB-D-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8435DB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 10A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8440-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8435DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI8435DB-T1-E1 Datenblatt	SI8435DB-T1-E1-Datenblätter	SI8435DB-T1-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8435DB-T1-E1
SI8435DB-T1-E1 Electronic	SI8435DB-T1-E1-Komponenten	SI8435DB-T1-E1-Verteiler	SI8435DB-T1-E1-Bild	SI8435DB-T1-E1-Teil
SI8435DB-T1-E1 Preis	SI8435DB-T1-E1 Hersteller	SI8435DB-T1-E1 Bild	SI8435DB-T1-E1 Aktie	SI8435DB-T1-E1 Inventar
SI8435DB-T1-E1 Neu	SI8435DB-T1-E1 Original	SI8435DB-T1-E1 garantiert	SI8435DB-T1-E1 RFQ	SI8435DB-T1-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited